

【書類名】 要約書

【要約】 ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

【課題】 半導体装置の製造工程において、平坦化性能が高く、かつ研磨量均一性と制御性に優れるウエハ表面パターンの平坦化加工を行う。

【解決手段】 少なくとも2種の異なる薄膜が露出する半導体ウエハを、砥石と、分散剤を添加した加工液を用いて研磨により平坦化する。

【効果】 砥石を用いた加工において分散剤を添加することで、膜種による研磨選択比が向上し、高い平坦化性能と、良好な加工量均一性を得られる。また加工の安定性、制御性が向上する。研磨レートが向上しスループットが増加するため、製造時間とコストを低減できる。特に、従来トレードオフの関係にあった平坦化性能と均一性を両立できるために、浅溝素子分離工程などの高精度な平坦化工程を簡易化し、コストを低減できる。

【選択図】 図1